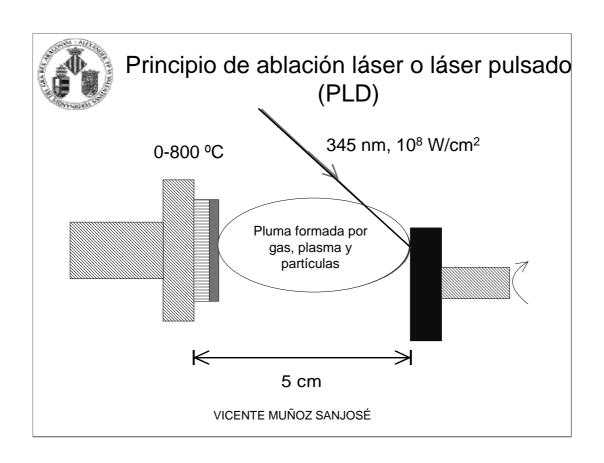


# Tecnología de Materiales

# Métodos de obtención de capas delgadas



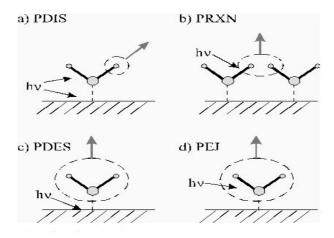
# Método de crecimiento de capas delgadas mediante Ablación Láser

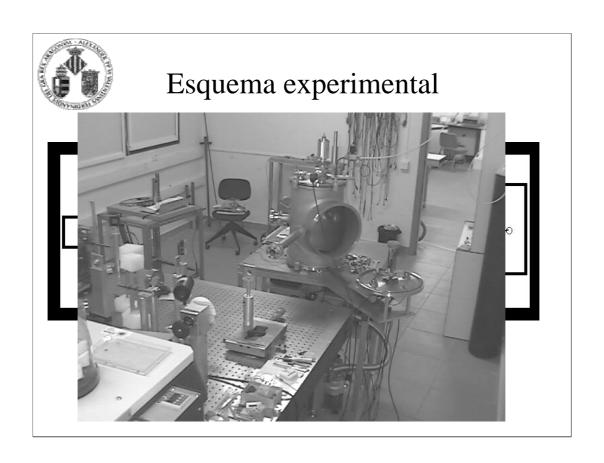


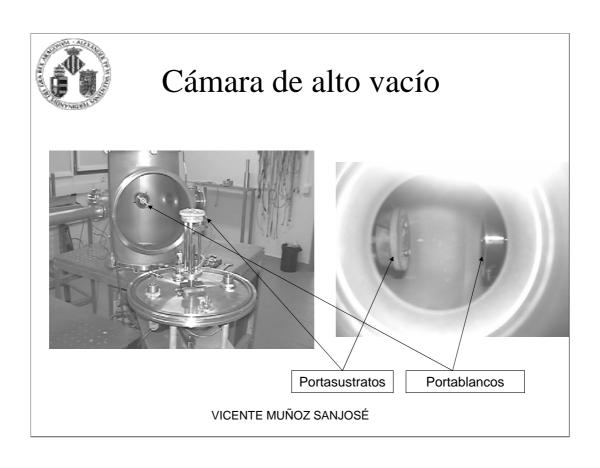


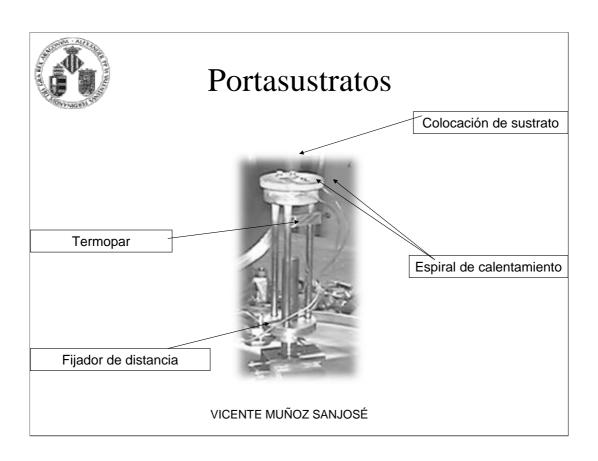
### Mecanismos térmicos y fotoquímicos

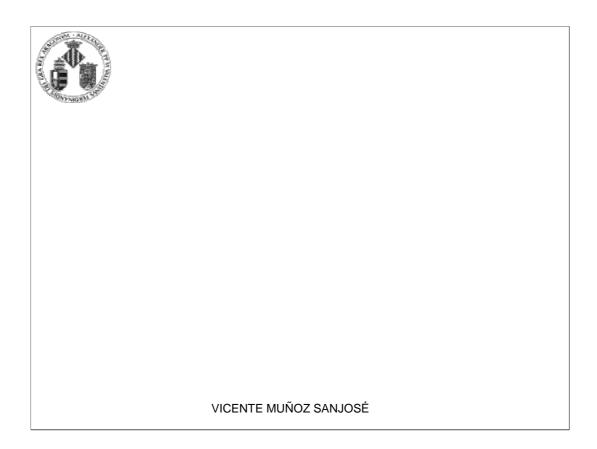
#### Mecanismos térmicos Mecanismos fotoquímicos:













# Condiciones de deposición

Láser:Nd-YAG triplicado:345 nm,10 o 20 Hz,7 ns,8-12 mJ/pulso

Atmósfera: O2 (vacío previo: 2 10-6 mBar)

Temperatura sustrato: 0-800°C



## Variables de la deposición

Control de la calidad y velocidad de crecimiento.

- a) Temperatura de sustrato.
- b) Energía cinética del flujo de deposición.
- c) Radio de deposición.
- d) Calidad de vacío.
- e) Gas de fondo.



## Temperatura de sustrato

#### Puede producir:

Procesos de reevaporación

Procesos de nucleación en clusters

Procesos de atrapado por un defecto en la superficie

#### Modos de crecimiento:

Islas o Volmer-Weber Capa a capa o Franck-Van der Merwe Mezcla



#### Energía del flujo de deposición

Aumentar la energía del pulso permite aumentar la energía cinética del flujo de deposición.

A partir de una determinada energía en el pulso se consigue crecimiento capa a capa.

Aumento de la energía del pulso permite disminuir la temperatura de sustrato para obtener misma calidad cristalina.



# Radio de deposición, calidad de vacío y gas de fondo.

#### Radio de deposición:

Depende del material

Malo tanto demasiado alto como demasiado bajo.

#### Calidad de vacío:

Evitar inclusión de impurezas

#### Gas de fondo:

Moderador de la velocidad, puede producir reacciones químicas o colisiones no reactivas entre el flujo energético y el propio gas.



# Materiales crecidos mediante este método

Class	Material
Oxides	YBCO, [19] ZnO, [20] TiO, [21] In: SnO [22]
Nitrides	AIN, [23] GaN, [24] BN, [25] CN [26]
Carbon based films	DLC, [27] Diamond, [28] Carbon nanotubes, [29]
	TiC <sup>18</sup>
Metals	Al, [30] Cu, [31], Fe [32]